十国像儿

第16卷 第7期

电流密度分布对 GaAs/GaAlAs 条形激光器的 瞬态温度特性的影响

张晓波

(吉林大学电子科学系,长春)

Current distribution effects on transient temperature characteristics of GaAs/GaAlAs stripe geometry lasers

Zhang Xiaobo

(Department of Electronic Sciences, Jilin University, Changchun)

提要:本文将电流密度的侧向分布考虑到热传导模型中去,对一般条形半导体 激光器的体内瞬态温度分布进行了计算,同时,利用光谱法对一些条形激光器的瞬态 温度进行了实验测量。计算结果同测量结果一致。

关键词: 半导体激光器,温度特性

一、引言

半导体条形激光器广泛地应用于光纤通 信中,而且,半导体激光器的瞬态工作特性正 在得到逐步开发和利用^[1]。与上述这些特性 紧密相关的是半导体激光器管芯的热阻及体 内温度分布^[2,3]。具有普遍意义的半导体激 光器与时间有关的热传导问题首先由W. Nakwaski 提出,并对简单的宽接触半导体激 光器进行了理论分析^[4]。但他仅讨论了一种 极为特殊的器件结构瞬态温度分布的问题。 本文在以前的工作^[5]的基础上,进一步给出 一般条形半导体激光器在考虑了注入电流分 布情况下的热传导模型,并将这一模型应用 到正装及倒装两种情况下的激光器管芯上, 从而得到了在管芯内由于能量损耗所带来的 温度升高,这种温度分布是随注入电流加入 的时间变化的。对考虑半导体激光器的瞬态 工作特性以及集成光学元件中的散热问题都 极有意义。本文中的计算方法对其它种类的 异质结半导体器件的温度分布问题也可适 用。

二、电流分布与温度分布模型

图1表示半导体激光器管芯的异质结构。

在有源层中电流密度侧向分布⁶⁰为 $J_{(y)}(y) = (I_0/l_0L) \exp[(-|y|+s/2)/l_0]$ (1)

$$\Pi J_e = \beta \rho_s I_0^2 / 2L^2, \quad I_0^2 = \frac{2L^2 J_e}{\beta \rho_s},$$

收稿日期: 1988年1月4日。



 $\frac{1}{l_0} = \frac{\beta \rho_s}{2L} \left[\frac{2L^2 J_e}{\beta \rho_s} \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\beta \rho_s J_e}$

可得到

$$J_{y}(y) = J_{e} \exp\left[-\left(|y| - s/2\right) \times \sqrt{2} / \sqrt{\beta \rho_{s} J_{e}}\right]$$
(2)

这里 ^{\$} 为条形激光器的电极条宽, ρ_• 为上限 制层及帽层的等效薄层电阻。在第 *i* 外延层 中的温度变化满足

$$C_{i} \frac{\partial T(x, y)}{\partial t} = K_{i} \left(\frac{\partial^{9} T(\chi, y)}{\partial x^{3}} + \frac{\partial^{9} T(x, y)}{\partial x^{2}} \right) + g_{i}(y)$$
(3)

这里 G_i 、 K_i 和 $g_i(y)$ 分别是第 i 层介质的每 单位体积比热、热传导系数和管芯中单位体 积的热产生率,其中 g_i 是坐标 y 的函数,并 且有

$$g_0 = J^2(y) \cdot \frac{\rho_{con}}{d_2} \tag{4}$$

$$g_1 = J^2(y) \cdot \rho_1 + V_j \cdot J_{th} \cdot \eta_{sp} \cdot f/(2d_1)$$

$$g_2 = J^2(y) \cdot \rho_2 \tag{6}$$

15

$$g_{3} = V_{j}/d_{3} \cdot [J_{th}(1 - \eta_{sp} \cdot f) + (J(y) - J_{th}) \\ \times [1 - \eta_{e\chi t} - (1 - \eta_{i})f \cdot \eta_{sp}] + J^{2}(y) \cdot \rho_{3}$$
(7)

 $g_4 =$

$$J^2(y) \cdot \rho_4 \tag{8}$$

$$_{5} = J^{2}(y) \cdot \rho_{5} + V_{j} \cdot J_{th} \cdot \eta_{sp} \cdot f/2d_{5} \quad (9)$$

$$g_6 = J^2(y) \cdot \rho_6 \tag{10}$$

式中 d_i 、 ρ_i 分别表示第i层的厚度和电阻率; ρ_{con} 是电极条与体芯的接触电阻; η_i 、 η_{ext} 、 η_{ey} 分别是内微分量子效率、外微分量子效率、自 发发射效率;常数f是从有源区内透射出的 自发发射的比例系数。在热源项中, $g_0(y)$ 、 $g_2(y)、g_4(y)、g_6(y) 只表示焦耳热,<math>g_1,g_5$ 两 项除焦耳热项以外还有对自发发射的吸收 项, g_3 表示有源层对非辐射复合、自发发射 以及受激辐射复合的吸收。几点近似:(a)有 相同的自发发射从有源区透射出在顶层和衬 底中吸收,而且吸收只发生在衬底靠近限制 层一侧 1 μ m 的层内;(b)每一外延层中热量 在其中均匀产生,(c) In 焊料以及热衬被认 为是良好的热导体,且热容量大,以致在器件 工作过程中,热衬的温度恒定。

在实际计算中,我们考虑到由于上限制 层及帽层中的电流扩展对计算结果影响不 大,所以在 g_0 、 g_1 、 g_2 项中J(y)除在电流注 入条区外都为零。 g_3 、 g_4 、 g_5 、 g_6 各项中的电 流分布都是采用同(2)式相同的分布形式,且 当J(y)小于 J_{th} 值时, $J(y) - J_{th}$ 取为0,此 时 J_{th} 用J(y)值代替。将方程(2)~(10)联 立起来,加上边界条件就可以求出激光器管 芯的瞬态温度分布。

三、计算结果

用有限元法来求解二维二次非线性偏微 分方程(3),并采用了不等间距网格取法。下 面将给出 6 μ m 电流注入条宽的氧化物条形 激光器的瞬态温度分布的计算结果 (图 2),计 算中的边界条件为管芯与空气接触面被认为 是绝热的,与热衬相接触面保持环境温度不 变(20°C)。图 3 的结果表明,窄条宽(6 μ m) 的激光器温度分布扩展较大,因此有源区中 温度最高点的值也要比 10 μ m 条宽的管芯 低。上述的结果是在 $J_e=1200$ A/cm², J_m = 1000 A/cm², $\rho_{con}=1\times10^{-5}\Omega\cdot cm^2$ 的条件 下计算出来的。



图 2 6 µm 条宽激光二极管芯的温度沿侧向 y 方向在不同的电流注入时间下的温度分布



为研究注入电流扩展效应对有源区温度 的影响,我们对比了 10 µm 条宽的激光器管 芯有源区内的温度升高在两种电流分布模型 下的计算结果,以及同实验结果的比较,见图 4。其中实验曲线的测量条件是:单纵模运转 下工作的样品器件是在 1.2 倍阈值脉冲注入 电流(In~1kA/cm²);为避免各电注入脉冲 之间在管芯内产生热的相互作用,取低占空 比1/200;脉冲宽度为 1000 ns;用取样示波器 测定电脉冲期间不同时刻的激射光波长,在 注入电脉冲过程中的光波长移动是由脉冲注 入过程中有源区中的温度升高造成的,因此 可推算出有源区中的温度升高。在测量时, 管芯被焊在铜热衬上,在热衬的下部装有热



▲ 线表示的是考虑到电流侧向分布时的计算结果;
B 线表示的是紧限制电流模型下所计算的结果;
带有标号的曲线是对不同管芯的测量结果。

电制冷器以保证热衬为 20℃不变。在计算 波长移动与有源区温度的关系时取波长随温 度变化率 0.3 nm/K。

图4中①、②、③是对三个典型管芯的 测量结果,可发现测量结果与理论计算结果 曲线 A基本一致,但在脉冲开启 100 ns 以后 计算结果同每个管芯的结果之间有些差别, 作者认为是由于每个管芯的特殊性造成的, 因为尽管已对所测管芯进行了严格挑选,但 它们之间以及同理论计算所要求的条件还会 有细微差别,如各外延层的材料性质等。但在 施加电脉冲 100 ns 内理论计算结果与各实验 测量值完全一致,这是因为在如此短的时间 从有源区散出的热量还没有传到热衬上,所 测管芯内的温度分布不受外界环境的影响。

图4还表明,在同一注入电流的情况下 考虑了侧向电流分布所计算的有源区温度升 高要比紧限制电流模型下计算的结果低许 多。下面可定性地对图4的结果给予解释, 根据公式 $I_t=2I_0+I_e$,有

$$J_t = \frac{2}{s} \sqrt{\frac{2J_e}{\beta \rho_s}} + J_e$$

在考虑了电流侧向分布模型中,实际决 定有源区温度的主要量是 J。,而在以前的紧 (下转第 393 页)





将α"看作连续变化的量,则由(20)式所 决定的 $\operatorname{Re}\lambda_n \sim \alpha_n$ 关系曲线如图2所示。显 然,倘若至少有一个腔频使得a,能导致 $\operatorname{Re}\lambda_n > 0$, 定态就成为不稳定的。若取C = 10, $n=0(从而 \alpha_n=0)$,则由(20)给出的 Re $\lambda_n \sim x$

(上接第409页)

限制电流模型中决定有源区温度的量是 J_t ,

附表. 理论计算所采用的一些常数值

ALL PAR CHARTER		
常数	数值	单位
Co	2.35	$Joule/K \cdot cm^3$
C_1	1.73	$Joule/K \cdot cm^3$
C_2	1.53	$Joule/K \cdot cm^3$
K_0	0.73	Watt/(cm·K)
K_1	0.50	Watt/(cm·K)
K_2	0.13	(cm·K)
P2	4.26×10^{-2}	Ω·cm
P4	1.4×10^{-2}	Ω·cm
$\rho_3 = \rho_5 = \rho_6$	2×10^{-3}	Ω·em
ρ1	7×10^{-3}	Ω·cm
ηερ	0.55	
nears	0.3	
η.	1	
f	0.65	

关系曲线如图3所示。这时若输出 x<3.6, 则会使 Re lo>0,从而定态就成为不稳定的。 图2、3纵轴以下为单位。

本文承陈继述教授的热情指导和审阅。 在此谨致谢意。

老文

献

- H. Haken, Z. Physik, 190, 327(1960)
- 1 2 H. Risken et al., Z. Physik, 194, 337 (1966)
- H. Haken, Phys. Lett., 53A, 77(1975) 3
- 4 E. N. Lorenz, J. Atoms. Sci., 20, 130(1963)
- 5 H. Risken et al., J. Appl. Phys., 39, 4662 (1968)
- R. Graham et al., Z. Physik, 213, 420(1968) 6
- 7 L. A. Lugiato et al., Opt. Commun., 46,57 (1983)
- Yiariv, A: Introduction to optical electronics, 8 2nd ed, New York, Holt Rinehart Winston (1976)
- Bonifacio R. et al., A: Lett. Nuovo Cimento, 21, 510(1978)

由此可以看出在同样的 It 条件下, 采用前者 所计算的有源区内的温度要比用后一种模型 计算的结果低。

作者对英国 Bath 大学电机系所提供的 计算工作条件表示感谢。

- 考文献
- 1 M. C. Perkins et al., IEE. Proc. Part I, 133 (4), (1986)
- 2 E. Duda et al., IEEE J. Quant. Electr., QE-15 (8), 812(1979)
- 3 W. B. Joyce et al., J. Appl. Phys., 46, 855 (1975)
- W. Nakwaski, Opt. Quant. Electr., (15), 313 (1983)
- 5 X. Zhang et al., J. Luminesence 40 & 41, 813 (1988)
- 6 H. C. Casey et al., Heterosturcture Lasers, Part B, (Academic Press, 1978) 219

. 393 .